

# 绝缘栅双极型晶体管-人体静电放电模式测试-百检网

产品名称	绝缘栅双极型晶体管-人体静电放电模式测试-百检网
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检集团汇聚国内外众多实验室，能提供工业消费品实验室、生态环境实验室、材料可靠性实验室、食品安全实验室、家电实验室、医疗卫生实验室、动物毒理测试实验中心、化妆品功效评价中心及适用于特殊试验的实验场地和检测服务。检测覆盖工业、建筑材料、汽车、矿产、石油化工、农产品及食品、消费产品、电子电气、健康毒理、化妆品、护理产品、医疗器械等多个领域上下游供应链，为生产、贸易、科研、技术研发及改进、标准研发、政府执法等提供全面、优质的专业检测服务；同时依托强有力科研背景，提供工艺诊断及改进、国内国际行业标准制定、新型产品及配方研发等相关配套服务。百检网综合平台合作的实验室机构凭借深厚的技术实力、优质的服务保障、的公信力、完善的资质能力与便捷的全国化服务网络，为国内外客户提供专业的检验检测认证技术服务。

1 半导体分立器件试验方法 MIL-STD-750F:2012 3407 集电极-发射极击穿电压

2 半导体分立器件试验方法 MIL-STD-750F:2012 3415 集电极-发射极漏流

3 半导体分立器件试验方法 MIL-STD-750F:2012 3405 集电极-发射极饱和压降

4 半导体器件分立器件第9部分：绝缘栅双极晶体管（IGBT）GB/T 29332-2012 6.3.5 栅极-发射极漏电流 IGES

5 半导体器件分立器件第9部分：绝缘栅双极晶体管（IGBT）GB/T 29332-2012 6.3.3 栅极-发射极阈值电压  $V_{GE(th)}$

6 半导体器件分立器件第9部分：绝缘栅双极晶体管（IGBT）GB/T 29332-2012 6.3.2 集电极-发射极饱和电压  $V_{CE(sat)}$

7 半导体器件分立器件第9部分：绝缘栅双极晶体管（IGBT）GB/T 29332-2012 6.3.4 集电极截止电流 ICES

8 半导体器件分立器件第9部分：绝缘栅双极晶体管（IGBT）GB/T 29332-2012 6.3.5 栅极-发射极漏电流(IGES)

9 半导体器件分立器件第9部分：绝缘栅双极晶体管（IGBT）GB/T 29332-2012 6.3.3 栅极-发射极阈值电压( $V_{GE(th)}$ )

10 半导体器件分立器件第9部分：绝缘栅双极晶体管（IGBT）GB/T 29332-2012 6.3.2 集电极-发射极饱和电压( $V_{CE(sat)}$ )

11 半导体器件分立器件第9部分：绝缘栅双极晶体管（IGBT）GB/T 29332-2012 6.3.4 集电极截止电流(ICES)

12 半导体器件分立器件第9部分：绝缘栅双极晶体管（IGBT）GB/T 29332-2012 6.3.3 栅极-发射极阈值电压

13 半导体器件分立器件第9部分：绝缘栅双极晶体管（IGBT）GB/T 29332-2012 6.3.5 栅极漏电流

14 半导体器件分立器件第9部分：绝缘栅双极晶体管（IGBT）GB/T 29332-2012 6.3.13 结到壳热阻/结到壳瞬态热阻抗

15 半导体器件分立器件第9部分：绝缘栅双极晶体管（IGBT）GB/T 29332-2012 6.3.2 集电极-发射极饱和电压

